

14A, 650V 超结 MOS功率管

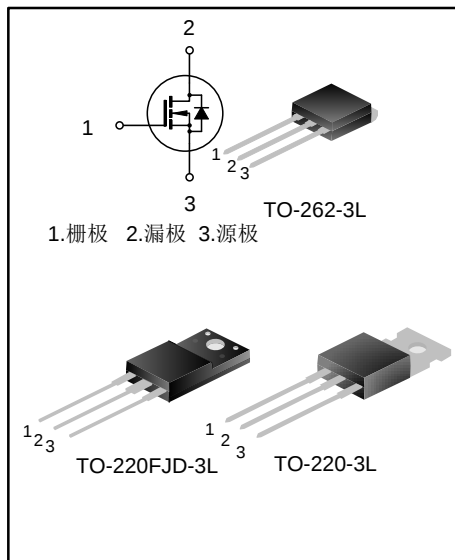
描述

SVSP14N65FJD/T/KD2 N 沟道增强型高压功率 MOSFET 采用士兰微电子超结 MOS 技术平台制造，具有很低的传导损耗和开关损耗。使得功率转换器具有高效，高功率密度，提高热行为。

此外，SVSP14N65FJD/T/KD2 应用广泛。如，适用于硬/软开关拓扑。

特点

- ◆ 14A,650V, $R_{DS(on)}$ (典型值)=0.26Ω@ $V_{GS}=10V$
- ◆ 创新高压技术
- ◆ 低栅极电荷
- ◆ 定期额定雪崩
- ◆ 较强 dv/dt 能力
- ◆ 高电流峰值



产品规格分类

产品名称	封装形式	打印名称	环保等级	包装方式
SVSP14N65FJDD2	TO-220FJD-3L	P14N65FJD	无卤	料管
SVSP14N65TD2	TO-220-3L	P14N65TD2	无卤	料管
SVSP14N65KD2	TO-262-3L	P14N65KD2	无卤	料管

极限参数(除非特殊说明, $T_A=25^{\circ}\text{C}$)

参 数		符 号	参数值		单 位
			SVSP14N65FJDD2	SVSP14N65TD2/KD2	
漏源电压		V _{DS}	650		V
栅源电压		V _{GS}	±30		V
漏极电流	T _C =25℃	I _D	14		A
	T _C =100℃		8.8		
漏极脉冲电流		I _{DM}	56		A
耗散功率(T _C =25℃) -大于25℃每摄氏度减少		P _D	35.7	139	W
			0.29	1.1	W/℃
单脉冲雪崩能量（注 1）		E _{AS}	593		mJ
反向二极管 dv/dt（注 2）		dv/dt	15		V/ns
MOS管 dv/dt 耐用性（注 3）		dv/dt	50		V/ns
工作结温范围		T _J	-55～+150		℃
贮存温度范围		T _{stg}	-55～+150		℃

热阻特性

参数	符号	参数值		单位
		SVSP14N65FJDD2	SVSP14N65TD2/KD2	
芯片对管壳热阻	$R_{\theta JC}$	3.50	0.9	$^{\circ}\text{C/W}$
芯片对环境的热阻	$R_{\theta JA}$	62.5	62.5	$^{\circ}\text{C/W}$

电气参数(除非特殊说明, $T_c=25^{\circ}\text{C}$)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
漏源击穿电压	BV_{DSS}	$V_{GS}=0V, I_D=250\mu A$	650	--	--	V
漏源漏电流	I_{DSS}	$V_{DS}=650V, V_{GS}=0V$	--	--	1.0	μA
栅源漏电流	I_{GSS}	$V_{GS}=\pm 30V, V_{DS}=0V$	--	--	± 100	nA
栅极开启电压	$V_{GS(th)}$	$V_{GS}=V_{DS}, I_D=250\mu A$	2.0	--	4.0	V
静态漏源导通电阻	$R_{DS(on)}$	$V_{GS}=10V, I_D=7.0A$	--	0.26	0.31	Ω
栅电阻	R_g	$f=1MHz$	--	2.7	--	Ω
输入电容	C_{iss}	$V_{DS}=100V, V_{GS}=0V,$ $f=1.0MHz$	--	802	--	pF
输出电容	C_{oss}		--	45	--	
反向传输电容	C_{rss}		--	2.5	--	
开启延迟时间	$t_{d(on)}$	$V_{DD}=325V, V_{GS}=10V,$ $R_G=24\Omega, I_D=14A$ (注 4,5)	--	13	--	ns
开启上升时间	t_r		--	37	--	
关断延迟时间	$t_{d(off)}$		--	59	--	
关断下降时间	t_f		--	32	--	
栅极电荷量	Q_g	$V_{DD}=520V, V_{GS}=10V, I_D=14A$ (注 4,5)	--	24	--	nC
栅极-源极电荷量	Q_{gs}		--	6.5	--	
栅极-漏极电荷量	Q_{gd}		--	11	--	

源-漏二极管特性参数

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
连续源极电流	I_S	MOS 管中源极、漏极构成的反偏 P-N 结	--	--	14	A
源极脉冲电流	I_{SM}		--	--	56	
二极管压降	V_{SD}	$I_S=14A, V_{GS}=0V$	--	--	1.4	V
反向恢复时间	T_{rr}	$V_{DD}=50V, I_F=14A,$ $dI_F/dt=100A/\mu s$ (注 4)	--	367	--	ns
反向恢复电荷	Q_{rr}		--	4.7	--	μC

注:

1. $L=79mH, I_{AS}=3.6A, V_{DD}=100V, R_G=25\Omega$, 开始温度 $T_J=25^{\circ}\text{C}$;
2. $V_{DS}=0\sim 400V, I_{SD}\leq 14A, T_J=25^{\circ}\text{C}$;
3. $V_{DS}=0\sim 480V$;
4. 脉冲测试: 脉冲宽度 $\leq 300\mu s$, 占空比 $\leq 2\%$;
5. 基本上不受工作温度的影响。



典型特性曲线

图1. 输出特性

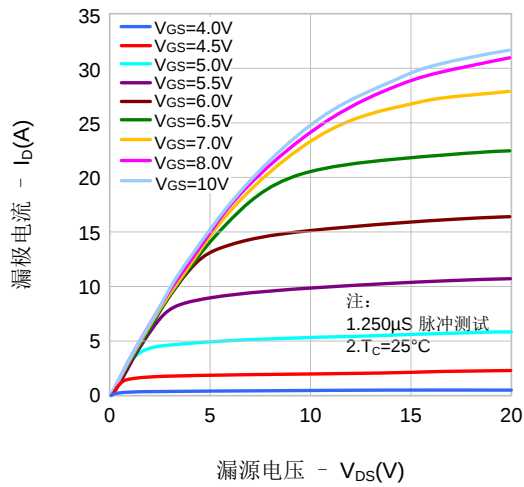


图2. 传输特性

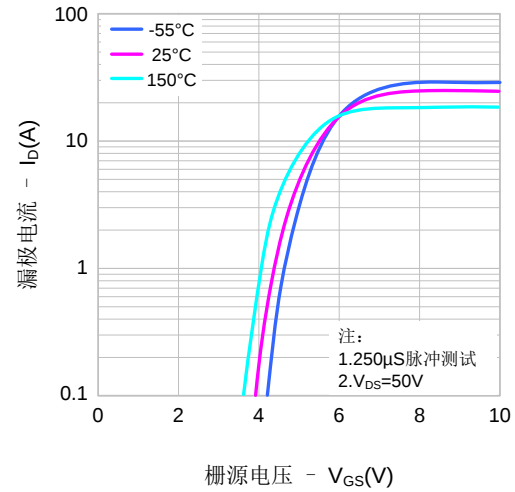


图3. 导通电阻vs.漏极电流

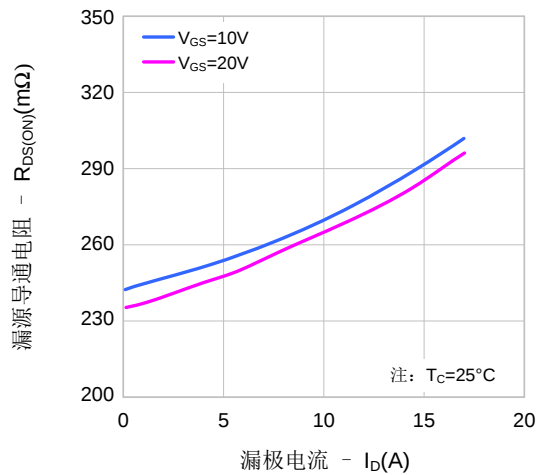


图4. 体二极管正向压降vs. 源极电流、温度

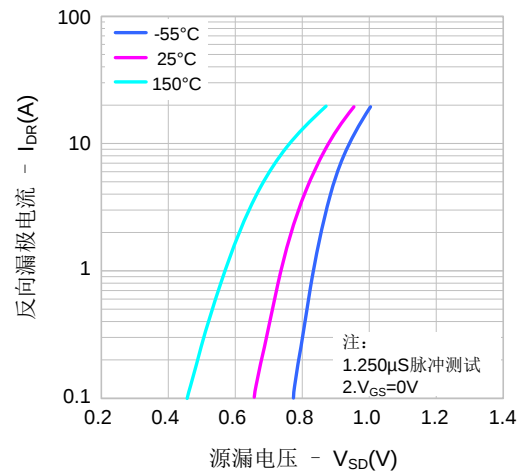


图5. 电容特性

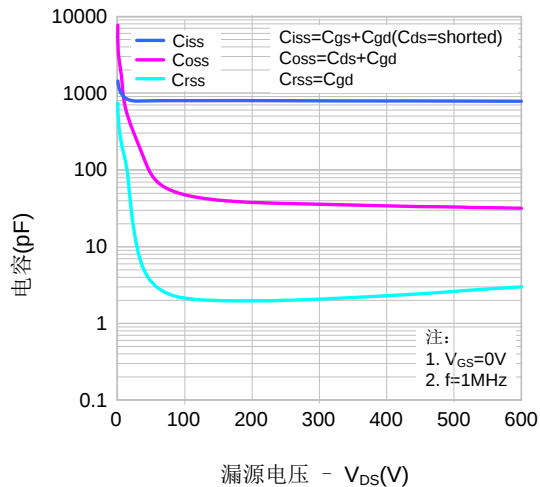
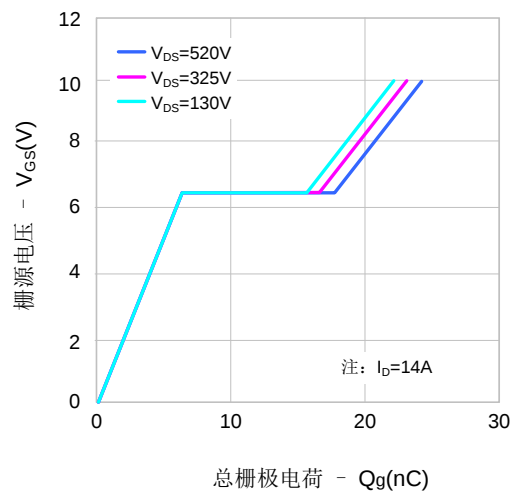


图6. 电荷量特性





典型特性曲线 (续)

图7. 击穿电压vs.温度特性

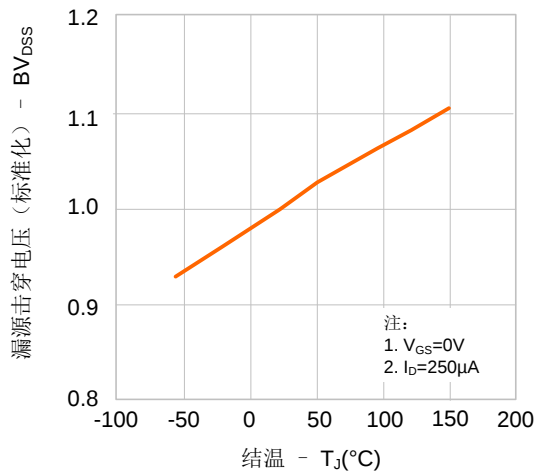


图8. 导通电阻vs.温度特性

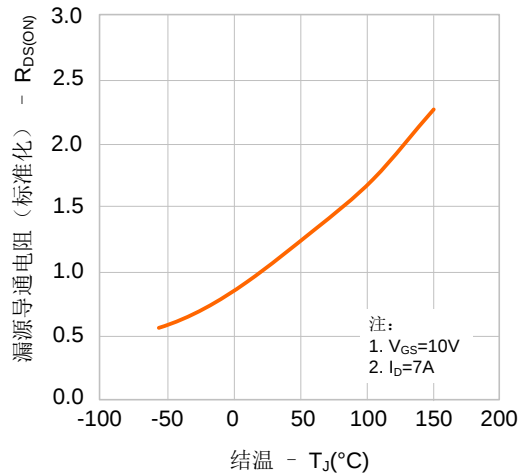


图9-1. 最大安全工作区域 (SVSP14N65FJDD2)

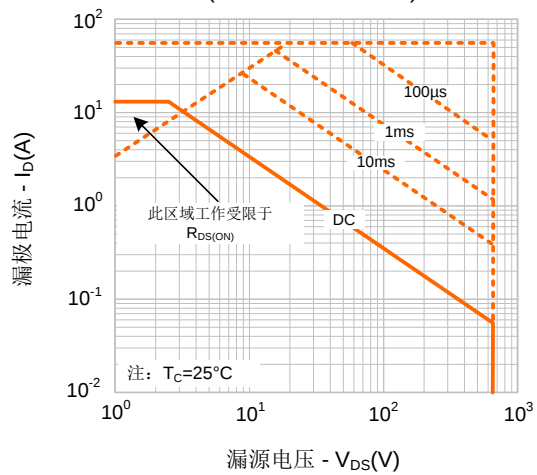
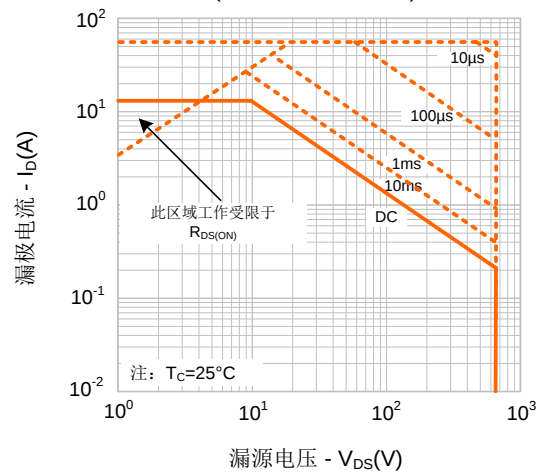
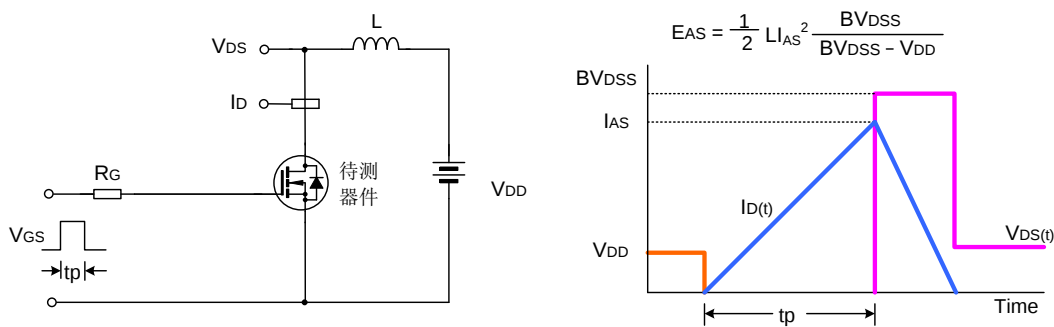
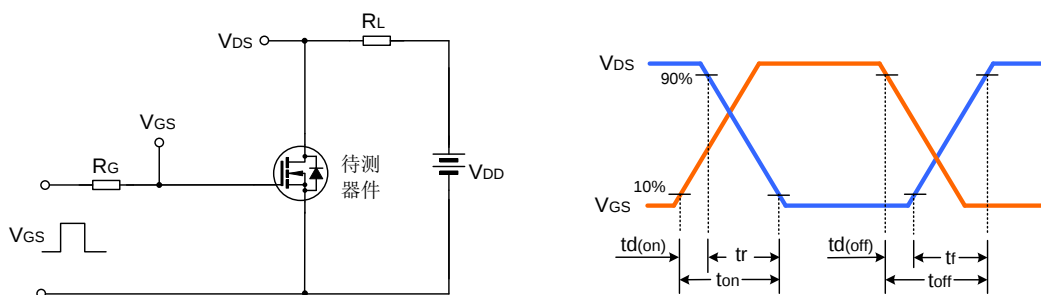
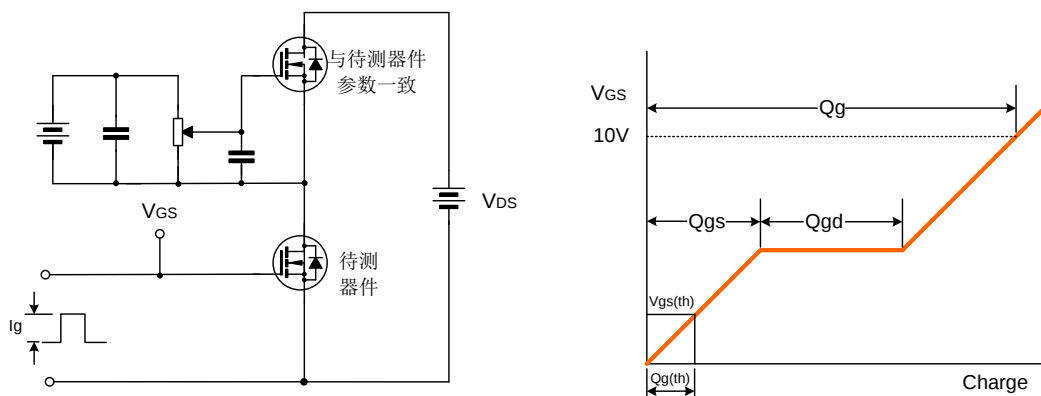


图9-2. 最大安全工作区域 (SVSP14N65T/KD2)



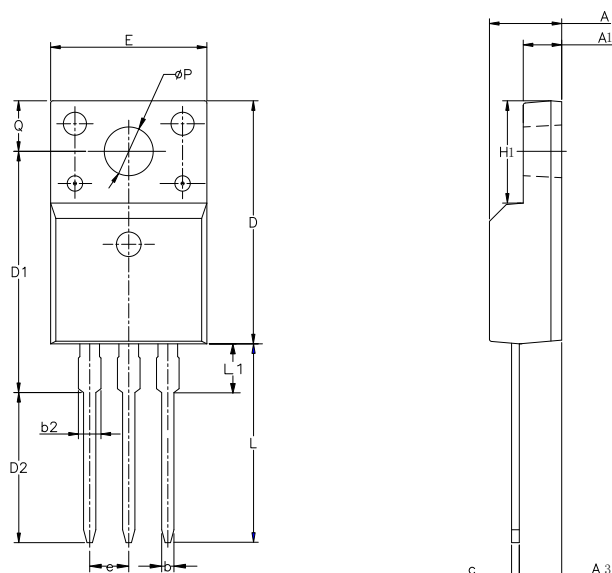
典型测试电路



封装外形图

TO-220FJD-3L

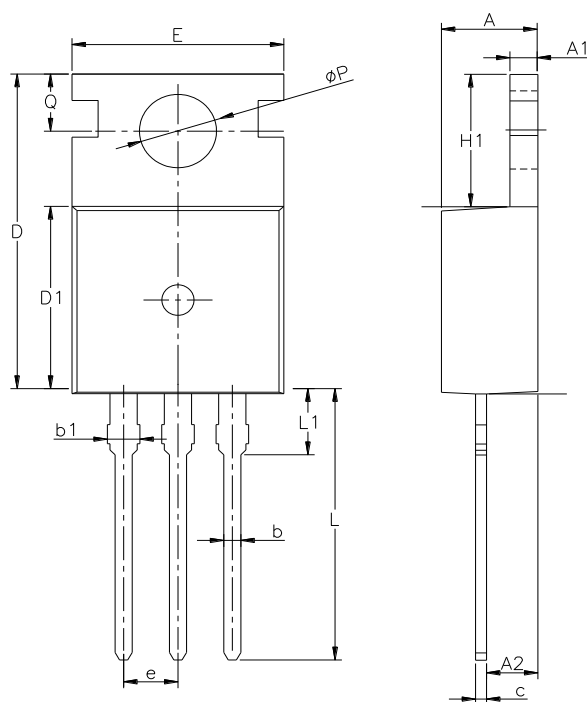
单位：毫米



SYMBOL	MIN	NOM	MAX
A	4.42	4.70	5.02
A1	2.30	2.54	2.80
A3	2.50	2.76	3.10
b	0.55	0.70	0.85
b2	—	—	1.29
c	0.35	0.50	0.65
D	15.25	15.87	16.25
D1	13.97	14.47	14.97
D2	10.58	11.08	11.58
E	9.73	10.16	10.36
e	2.54BCS		
H1	6.40	6.68	7.00
L	12.48	12.98	13.48
L1	—	—	2.00
φP	3.00	3.18	3.40
Q	3.05	3.30	3.55

TO-220-3L

单位：毫米

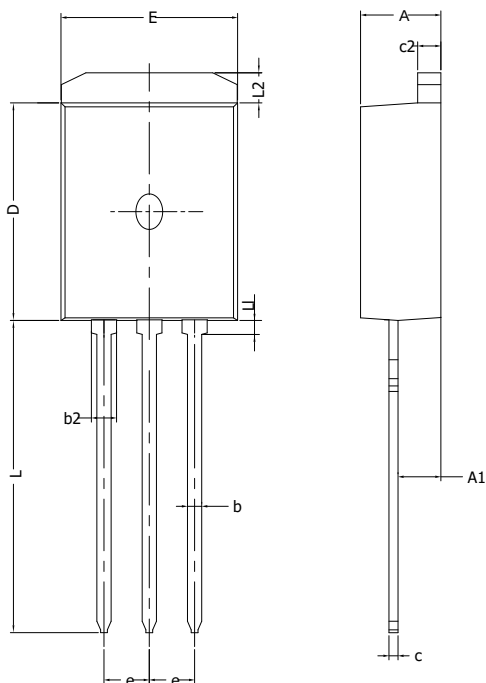


SYMBOL	MIN	NOM	MAX
A	4.30	4.50	4.70
A1	1.00	1.30	1.50
A2	1.80	2.40	2.80
b	0.60	0.80	1.00
b1	1.00	—	1.60
c	0.30	—	0.70
D	15.10	15.70	16.10
D1	8.10	9.20	10.00
E	9.60	9.90	10.40
e	2.54BSC		
H1	6.10	6.50	7.00
L	12.60	13.08	13.60
L1	—	—	3.95
φP	3.40	3.70	3.90
Q	2.60	—	3.20

封装外形图（续）

TO-262-3L

单位：毫米



SYMBOL	MIN	NOM	MAX
A	4.30	4.50	4.70
A1	2.20	---	2.92
b	0.71	0.80	0.90
b2	1.20	---	1.50
c	0.34	---	0.65
c2	1.22	1.30	1.35
D	8.38	---	9.30
E	9.80	10.16	10.54
e	2.54 BSC		
L	12.80	---	14.10
L1	---	---	0.75
L2	1.12	---	1.42

重要注意事项：

- 士兰保留说明书的更改权，恕不另行通知。客户在下单前应获取我司最新版本资料，并验证相关信息是否最新和完整。
- 我司产品属于消费类和/或民用类电子产品。
- 在应用我司产品时请不要超过产品的最大额定值，否则会影响整机的可靠性。任何半导体产品特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能，买方有责任在使用我司产品进行系统设计、试样和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施，以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生。
- 购买产品时请认清我司商标，如有疑问请与本公司联系。
- 转售、应用、出口时请遵守中国、美国、英国、欧盟等国家、地区和国际出口管制法律法规。
- 产品提升永无止境，我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品！
- 我司网站 <http://www.silan.com.cn>

产品名称:	SVSP14N65FJD (T)KD2	文档类型:	说明书
版 权:	杭州士兰微电子股份有限公司	公司主页:	http://www.silan.com.cn

版 本: 1.2

修改记录:

1. 修改电气图和典型电路图
2. 修改图 5 特性曲线

版 本: 1.1

修改记录:

1. 修改规格书中 I_{GSS} 测试条件

版 本: 1.0

修改记录:

1. 正式版本发布